

PNP Darlington Transistor

BDX66B

100V / 20A

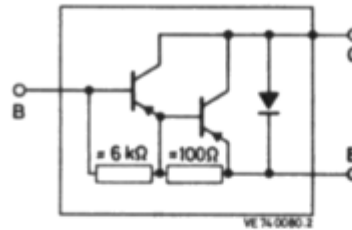
DATASHEET

OEM – Valvo

Source: Valvo Databook 1976

BDX 66
BDX 66 A
BDX 66 B

SILIZIUM - PNP - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN

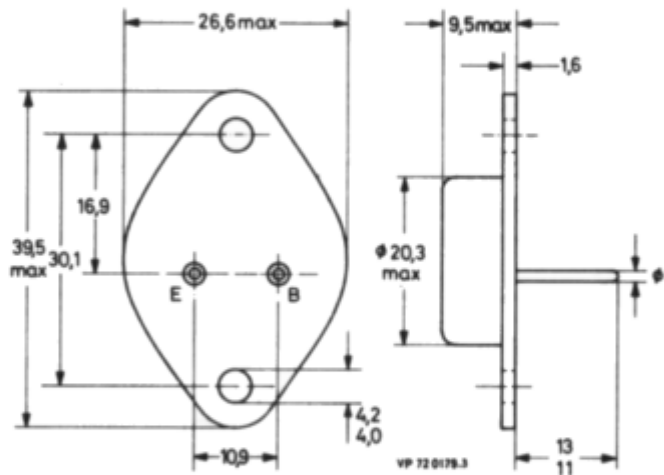


Mechanische Daten:

Gehäuse: Metall
JEDEC T0-3

Der Kollektor ist mit dem Gehäuse leitend verbunden.

Maßangaben in mm.



<u>Kurzdaten:</u>		BDX 66	BDX 66A	BDX 66B	
Kollektor-Sperrspannung	$-U_{CB0} = \text{max.}$	60	80	100	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$-U_{CE0} = \text{max.}$	60	80	100	V
Kollektorstrom, Scheitelwert	$-I_{CM} = \text{max.}$		20		A
Gesamtverlustleistung	$P_{tot} = \text{max.}$		150		W
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_J = \text{max.}$		200		$^{\circ}\text{C}$
Gleichstromverstärkung					
bei $-U_{CE} = 3 \text{ V}, -I_C = 10 \text{ A}$	B	\geq	1000		
Transit-Frequenz					
bei $-U_{CE} = 3 \text{ V}, -I_C = 5 \text{ A}$	f_T	=	7		MHz

BDX 66

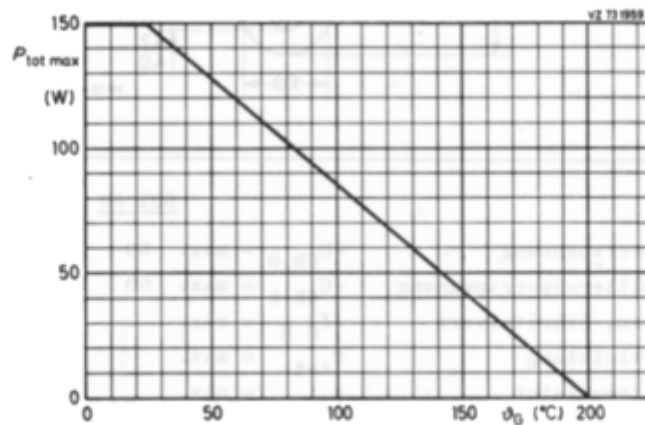
BDX 66 A

BDX 66 B

<u>Absolute Grenzwerte:</u> (gültig bis $\vartheta_{J \text{ max}}$)		<u>BDX 66</u>	<u>BDX 66A</u>	<u>BDX 66B</u>	
Kollektor-Sperrspannung bei $I_E = 0$:	$-U_{CB 0} = \text{max.}$	60	80	100	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei $I_B = 0$:	$-U_{CE 0} = \text{max.}$	60	80	100	V
Emitter-Sperrspannung bei $I_C = 0$:	$-U_{EB 0} = \text{max.}$	5	5	5	V
Kollektorstrom, Mittelwert:	$-I_{C \text{ AV}} = \text{max.}$		16		A
Kollektorstrom, Scheitelwert:	$-I_{C \text{ M}} = \text{max.}$		20		A
Basisstrom:	$-I_B = \text{max.}$		250		mA
Gesamtverlustleistung:	$P_{\text{tot}} = \text{max.}$		150		W
Sperrschichttemperatur:	$\vartheta_J = \text{max.}$		200		$^{\circ}\text{C}$
Lagerungstemperatur:	$\vartheta_S = \text{min.}$		-55		$^{\circ}\text{C}$
	$\vartheta_S = \text{max.}$		200		$^{\circ}\text{C}$

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Gehäuseboden:	$R_{\text{th G}} \leq$	1,17	K/W
--	------------------------	------	-----

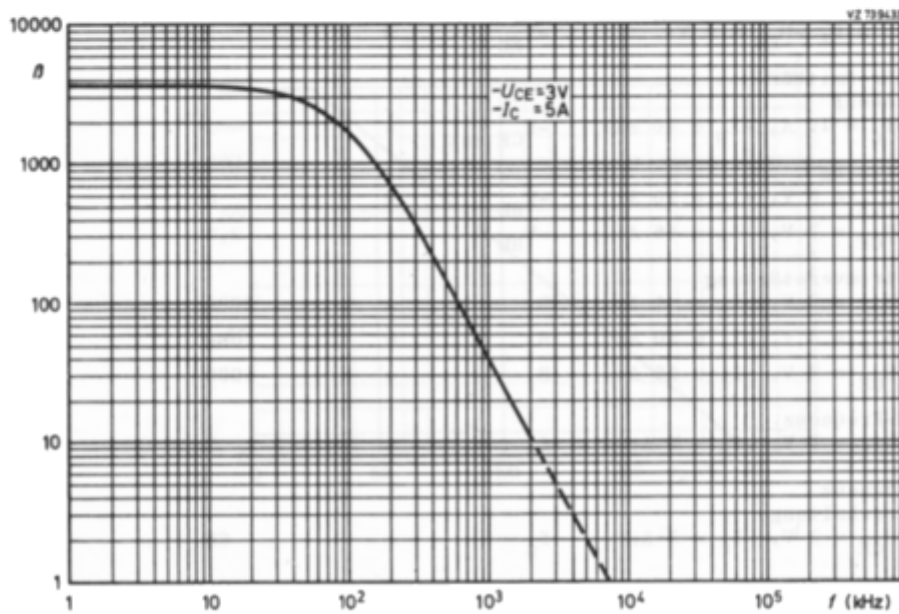
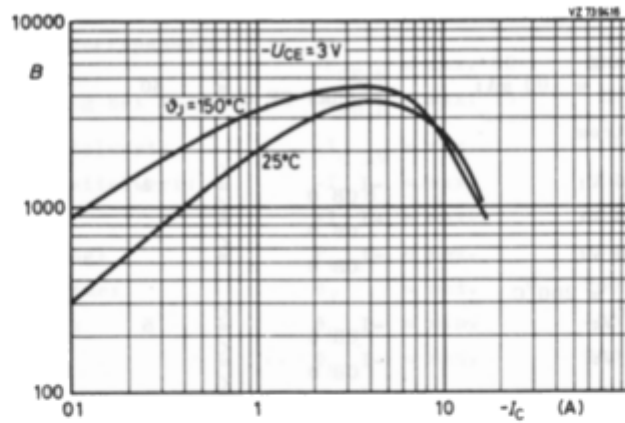


BDX 66 BDX 66 A BDX 66 B

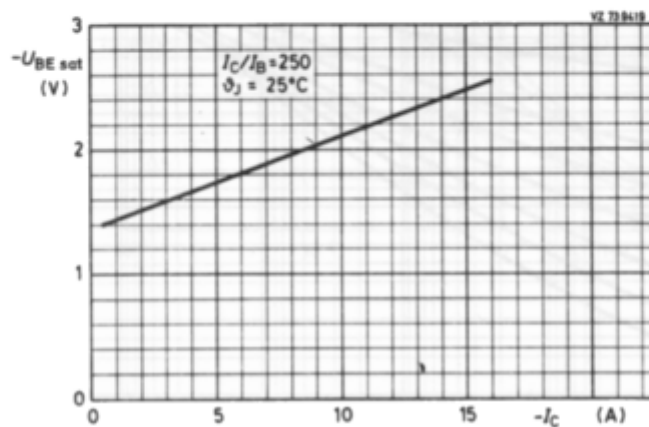
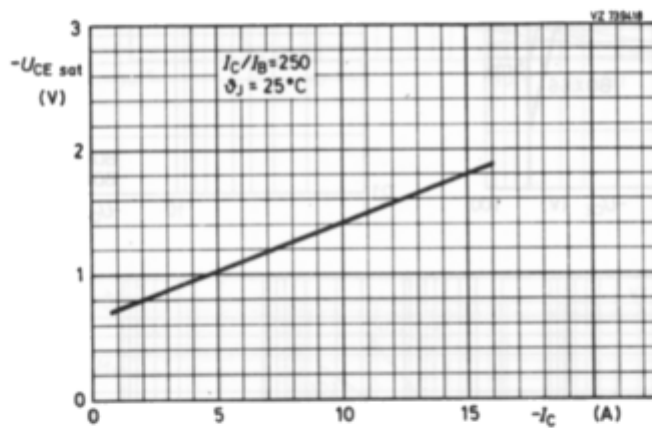
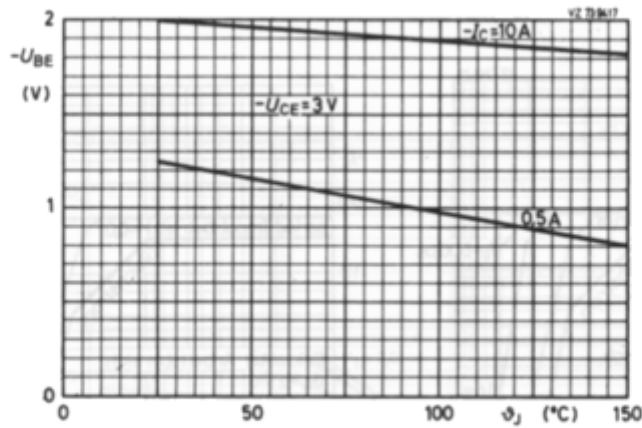
Kennwerte: bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$, sofern nicht anders angegeben

		<u>BDX 66</u>	<u>BDX 66A</u>	<u>BDX 66B</u>	
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei $I_B = 0$, $-I_C = 100\text{ mA}$:	$-U_{(BR) CE 0} \geq$	60	80	100	V
Kollektor-Reststrom bei $I_E = 0$ und $-U_{CB} = 60\text{ V}$:	$-I_{CB 0} \leq$	1			mA
und $-U_{CB} = 80\text{ V}$:	$-I_{CB 0} \leq$		1		mA
und $-U_{CB} = 100\text{ V}$:	$-I_{CB 0} \leq$			1	mA
bei $I_E = 0$, $\vartheta_J = 200^\circ\text{C}$ und $-U_{CB} = 40\text{ V}$:	$-I_{CB 0} \leq$	5			mA
und $-U_{CB} = 50\text{ V}$:	$-I_{CB 0} \leq$		5		mA
und $-U_{CB} = 60\text{ V}$:	$-I_{CB 0} \leq$			5	mA
Kollektor-Emitter-Reststrom bei $I_B = 0$, $-U_{CE} = 30\text{ V}$:	$-I_{CE 0} \leq$	3			mA
bei $I_B = 0$, $-U_{CE} = 40\text{ V}$:	$-I_{CE 0} \leq$		3		mA
bei $I_B = 0$, $-U_{CE} = 50\text{ V}$:	$-I_{CE 0} \leq$			3	mA
Emitter-Reststrom bei $I_C = 0$, $-U_{EB} = 5\text{ V}$:	$-I_{EB 0} \leq$		2		mA
Kollektor-Emitter-Restspannung bei $-I_C = 10\text{ A}$, $-I_B = 40\text{ mA}$:	$-U_{CE sat} \leq$		2		V
Basisspannung bei $-U_{CE} = 3\text{ V}$, $-I_C = 10\text{ A}$:	$-U_{BE} \leq$		3		V
bei $-U_{CE} = 3\text{ V}$, $-I_C = 16\text{ A}$:	$-U_{BE} =$		2,5		V
Gleichstromverstärkung bei $-U_{CE} = 3\text{ V}$, $-I_C = 1\text{ A}$:	$B \geq$		2000		
bei $-U_{CE} = 3\text{ V}$, $-I_C = 10\text{ A}$:	$B \geq$		1000		
bei $-U_{CE} = 3\text{ V}$, $-I_C = 16\text{ A}$:	$B =$		1000		
Transit-Frequenz bei $-U_{CE} = 3\text{ V}$, $-I_C = 5\text{ A}$:	$f_T =$		7		MHz
Grenzfrequenz (Emitterschaltung) bei $-U_{CE} = 3\text{ V}$, $-I_C = 5\text{ A}$:	$f_B =$		60		kHz
Durchlaßspannung der Schutzdiode bei $I_P = 10\text{ A}$:	$U_P =$		2		V

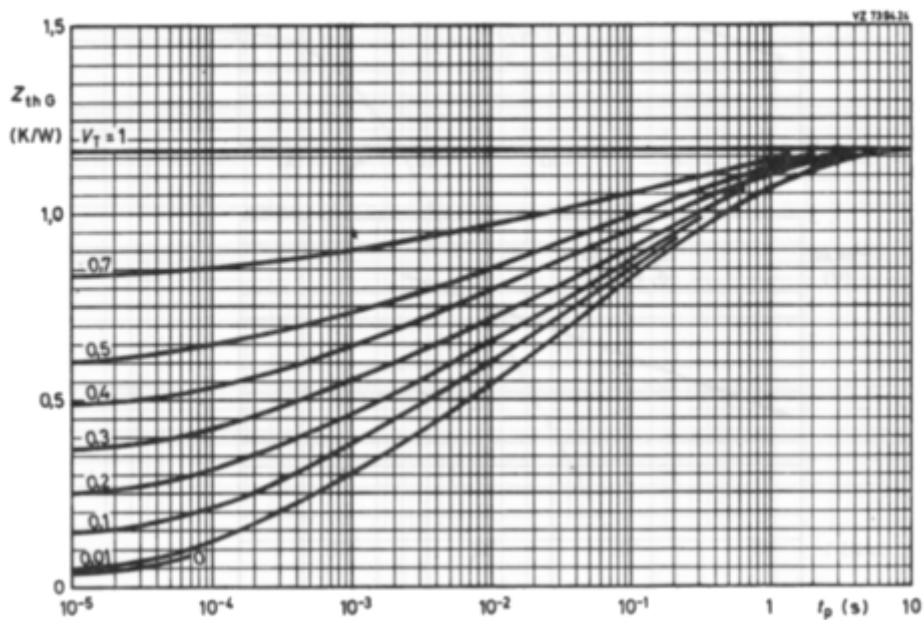
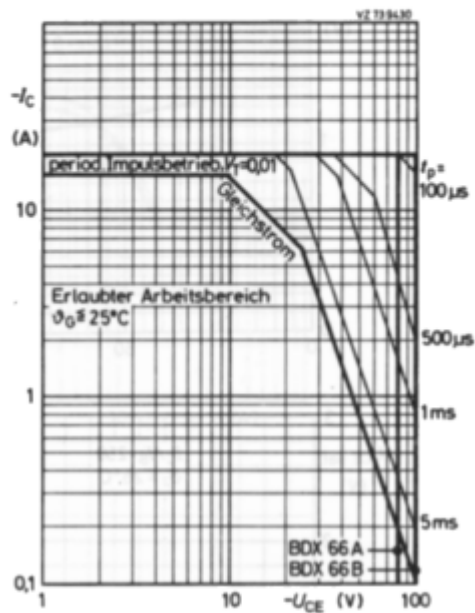
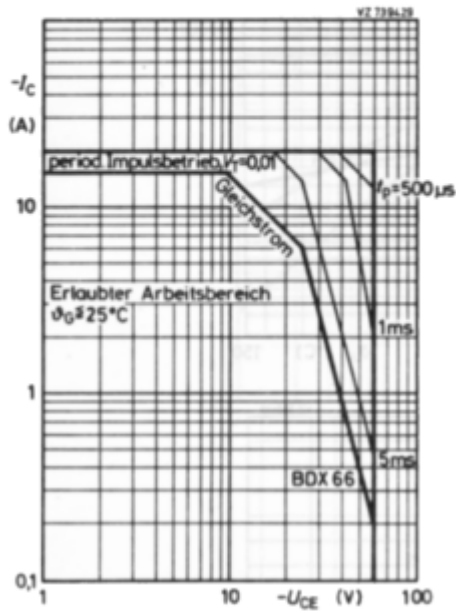
BDX 66
BDX 66 A
BDX 66 B



BDX 66
BDX 66 A
BDX 66 B



BDX 66
BDX 66 A
BDX 66 B



BDX 66
BDX 66 A
BDX 66 B

